

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón)

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

N.º 3272

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Consultas de los clientes

Power Device Overseas Marketing Dept.A and Dept.B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Consultas de los medios

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

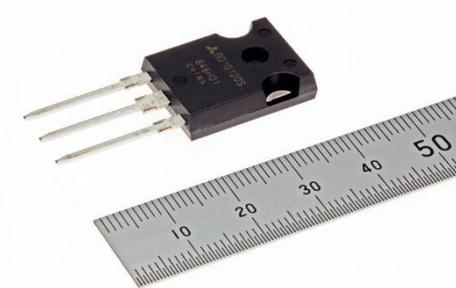
www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric lanza un diodo de barrera Schottky de carburo de silicio de 1200 V

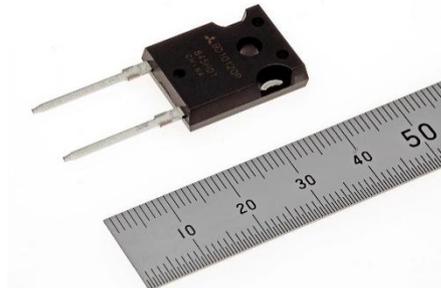
El nuevo diodo reduce la pérdida de potencia y el tamaño físico de los sistemas de alimentación

TOKIO, 27 de marzo de 2019 – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo diodo de barrera Schottky de carburo de silicio de 1200 V (SiC-SBD) que reduce la pérdida potencia y el tamaño físico de los sistemas de suministro energético destinados a infraestructuras y sistemas de energía fotovoltaica, entre otros. Los envíos de muestras comenzarán en junio de 2019, y las ventas, en enero de 2020.

Los diodos se exhibirán en las ferias comerciales más importantes, que incluyen MOTORTECH JAPAN 2019 durante la TECHNO-FRONTIER 2019 en el complejo de Makuhari Messe, en Chiba, Japón, del 17 al 19 de abril; PCIM Europe 2019 en Núremberg, Alemania, del 7 al 9 de mayo; y PCIM Asia 2019 en Shanghái, China, del 26 al 28 de junio.



Paquete SiC-SBD TO-247 de 1200 V



Paquete SiC-SBD TO-247-2 de 1200 V

Características del producto

- 1) ***Carburo de silicio que ayuda a reducir la pérdida de potencia y el tamaño de los paquetes***
 - La conversión de energía es más eficaz, con aproximadamente un 21 % menos de pérdida de potencia en comparación con los productos de silicio (Si).
 - Permite la conmutación de alta velocidad y el uso de componentes periféricos de menor tamaño, como los reactores.
- 2) ***Mayor fiabilidad gracias a la estructura de barrera de uniones Schottky (JBS)***
 - Combina la barrera de Schottky con las uniones p-n.
 - La estructura de JBS ayuda a lograr una alta fiabilidad.
- 3) ***Ampliación de la línea para su uso en más aplicaciones***
 - El paquete TO-247-2, que cuenta con una mayor distancia de espacio libre de aislamiento, se incorpora a la gama actual TO-247 con el fin de cubrir más aplicaciones, incluidas las relativas a bienes de consumo.
 - Cumple la especificación AEC-Q101 del Automotive Electronics Council en materia de uso en automóviles (solo el modelo BD20120SJ).

Programa de ventas

Serie	Modelo	Paquete	Especificación	Disponibilidad de muestras	Lanzamiento
SiC-SBD de 1200 V	BD10120P	TO-247-2	1200 V/10 A	Junio de 2019	Enero de 2020
	BD20120P		1200 V/20 A		
	BD10120S	TO-247	1200 V/10 A		Abril de 2020
	BD20120S		1200 V/20 A		
	BD20120SJ		AEC-Q101 de 1200 V/20 A		

Desde que comenzara a comercializar su primer módulo de alimentación con SiC-SBD y SiC-MOSFET en 2010, Mitsubishi Electric trabaja sin cesar con el fin de reducir el tamaño y mejorar la eficiencia energética de los sistemas inversores. Cada vez es más frecuente que los consumidores opten por productos con SiC-SBD, como sistemas de suministro energético eficientes para aires acondicionados, equipos industriales y vehículos ferroviarios, entre otros. Por su parte, la nueva serie SiC-SBD de 1200 V ayuda a responder a esta mayor demanda de semiconductores discretos para la generación de energía fotovoltaica y la carga de vehículos eléctricos (VE).

Nota: El desarrollo de estos productos SiC ha contado con el apoyo parcial de la organización para el desarrollo de energías nuevas y tecnologías industriales (NEDO) de Japón.

Especificaciones principales

Modelo	BD10120S	BD10120P	BD20120S(J)	BD20120P
Especificación	1200 V/10 A		1200 V/20 A	
Pico de intensidad de corriente directa no repetitiva (máx.*)	95 A		155 A	
Voltaje directo (típico) Temperatura de funcionamiento = 25 °C	1,35 V			
Paquete	TO-247	TO-247-2	TO-247	TO-247-2
Tamaño	15,9 × 41,0 × 5,0 mm			

*8,3 ms, onda senoidal

Línea de la serie SiC-SBD

(Los productos nuevos aparecen en negrita)

Serie	Modelo	Especificación		Paquete	Suministro
		Tensión [V]	Corriente [A]		
SiC-SBD	BD10120S	1200	10	TO-247	Las muestras estarán disponibles a partir de junio de 2019
	BD10120P			TO-247-2	
	BD20120S		TO-247		
	BD20120SJ		TO-247		
	BD20120P		TO-247-2		
	BD20060S	600	20	TO-247	Las muestras ya están disponibles
	BD20060A			TO-263S	
	BD20060T			TO-220FP-2	Ya en el mercado

Conciencia medioambiental

Estos productos cumplen con las directivas 2011/65/UE y 2015/863/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS en inglés).

###

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con casi 100 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa registró ventas de grupo consolidadas de 4 444 400 millones de yenes (según las NIIF, unos 41 900 millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018. Para obtener más información, visite:

www.MitsubishiElectric.com

*Tipo de cambio de 106 yenes por dólar estadounidense, fijado por el Mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2018